

## „Novel Optics“ Neuartige Wirkprinzipien

### Verbund GaNonSi

Effiziente, kostengünstige InGaN-Lichtquellen auf Silizium-Substraten für die Allgemeinbeleuchtung  
01.02.2009 - 31.01.2012

<b>FKZ</b>	<b>Teilvorhaben</b>	<b>Projektpartner</b>
13N10251	Epitaxie und Chiptechnologie von InGaN-Leuchtdioden auf Silizium-Substraten	OSRAM Opto Semiconductors GmbH
13N10252	MOVPE-Schichttechnologie für GaN-Hochleistungsleuchtdioden auf Silizium	AZZURRO Semiconductors AG
13N10253	Mikrooptische und strukturelle Charakterisierung von GaN-auf-Silizium Strukturen	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
13N10254	Elektronenmikroskopische Charakterisierung und Modellierung von Versetzungsprozessen von InGaN-Lichtquellen auf Silizium-Substraten für die Allgemeinbeleuchtung	Forschungsverbund Berlin e.V. - Leibniz-Institut für Kristallzüchtung
13N10255	Herstellung effektiver AlN/GaN Nukleationsschichten auf Si mit MBE und Untersuchungen der aktiven InGaN Quantenwellschichten	Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) im Forschungsverbund Berlin e.V.
<b>Gesamtzusammenfassung</b>		<b>2.976.700 €</b>